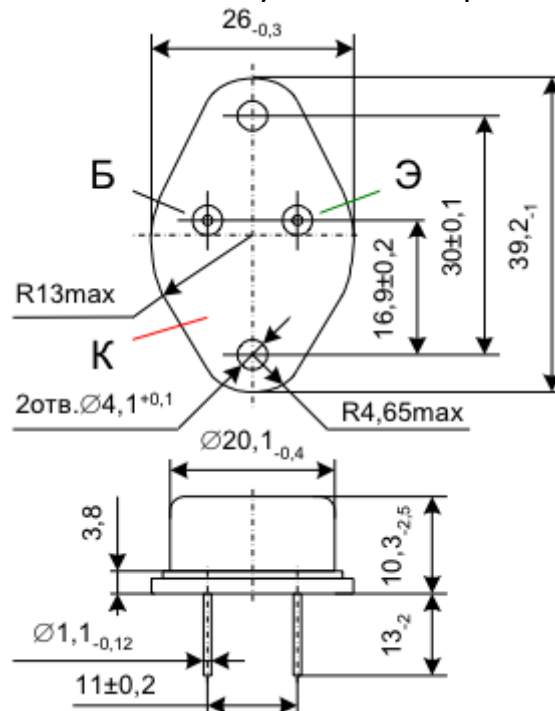


КТ812В

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры n-p-n импульсные.

Предназначены для применения в импульсных и переключательных устройствах.



Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

Тип корпуса: КТ-9. Масса транзистора не более 20 г.

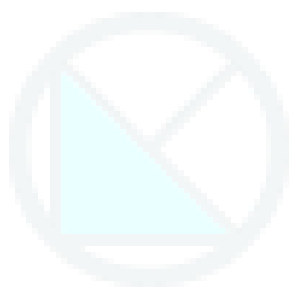
Технические условия: аА0.336.052 ТУ.

Изготовитель - АО «Элиз», г. Фрязино.

Основные технические характеристики транзистора КТ812В:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока для схем с ОЭ при $U_{кэ}=2,5$ В, $I_{к}=8$ А: не менее 10;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока для схем с ОЭ: не менее 3 МГц;
- $U_{кэ\text{ нас}}$ – Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{к}=8$ А, $I_{б}=1,6$ А: не более 2,5 В;
- $U_{бэ\text{ нас}}$ – Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{к}=8$ А, $I_{б}=1,6$ А: не более 2,5 В;
- $t_{сп}$ - Время спада при $U_{кэ}=250$ В, $I_{к}=5$ А, $I_{б}=2,5$ А, $U_{бэ}=4$ В: 0,22...1,3 мкс;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб}=300$ В, $t_{к}=+25^{\circ}\text{C}$: не более 5 мА;
- $I_{эбо}$ - Обратный ток эмиттера при $U_{эб}=7$ В: не более 150 мА;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 100 пФ;
- $U_{кэг\text{ max}}$ - Максимальное импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ}=10$ Ом, $t_{к}\leq+85^{\circ}\text{C}$, $t_{и}\leq 1$ мс, $Q\geq 10$: 300 В;

- $U_{эб0 \max}$ – Максимальное постоянное напряжение база- эмиттер: 7 В;
- $I_k \max$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 8 А;
- I_k и t_{\max} - Максимально допустимый импульсный ток коллектора при $t_{\text{и}} \leq 1$ мс, $Q \geq 10$: 12 А;
- $P_k \max$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $t_k \leq +50^\circ\text{C}$: не более 50 Вт.
- t_p – Температура р-п перехода: не более + 150°C;
- $t_{\text{окр}}$ – Температура окружающей среды: -45... t_k =+85°C.



РАДИОЭЛЕМЕНТ